

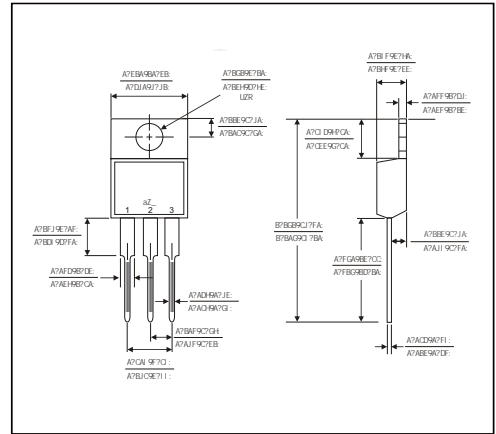
220AB

Features

ÜÖÛÇUPÐÁMHÈÌÀOXÕÙÁMFEXÁÈ
 Š [, Á * æ ^ Á & @ æ : * ^ Á Ç Á c ^] á & æ] Á J É É Á } Ô D È
 Š [, Á Ô ! • • Á Ç Á c ^] á & æ] Á J É É Á } Ø D È
 Ø æ • c Á • , á c & @ á } * Á & æ] æ à ð] á c ^ È
 Ç ç æ] æ } & @ ^ Á ^ } ^ ! * ^ Á •] ^ & ã - ã ^ Á Á Q {] ! [Ç ^ á Á á Ç ð á c Á & æ] æ à ð] á c ^ È
 Þ È Ô @ æ } } ^ Á T U U Ø Ó V

KVUEG Á

Á



Parameter	Symbol	Rating	Unit
Drain-Source Voltage	V _{DSS}	600	V
Gate-Source Voltage	V _{GSS}	± 30	V
Drain Current - Continuous (T _c = 25 °C)	I _D	2.0	A
Continuous (T _c = 100 °C)		1.26	A
Drain Current - Pulsed * 1	I _{DP}	8.0	A
Single Pulsed Avalanche Energy * 2	E _{AS}	140	mJ
Avalanche Current * 1	I _{AR}	2.0	A
Repetitive Avalanche Energy * 1	E _{AR}	4.5	mJ
Peak Diode Recovery dv/dt * 3	dv/dt	4.5	V/ns
Power Dissipation (T _c = 25 °C)	P _D	44	W
Derate above 25 °C		0.36	W/ °C
Operating and Storage Temperature Range	T _J , T _{stg}	- 55 to + 150	°C
Maximum lead temperature for soldering purposes, 1/8" from case for 5 seconds	T _L	300	°C
Thermal Resistance, Junction-to-Case	R _{θJC}	4	°C/W
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	R _{θJA}	54	°C/W

* 1. Repetitive Rating : Pulse width limited by maximum junction temperature.

* 2. L = 64mH, I_{AS} = 2.0A, V_{DD} = 50V, R_G = 25 Ω, Starting T_J = 25 °C

* 3. I_{SD} ≤ 2.4A, di/dt ≤ 200A/μs, V_{DD} ≤ BV_{DSS}, Starting T_J = 25 °C